Express
SANYO 三洋半導体開発速報
No.※5530
51096

2SK2633LS—NチャネルMOS形シリコン電界効果トランジスタ 超高速スイッチング用

暫定規格

特長　・低オン抵抗。
　　　・低Qg化。

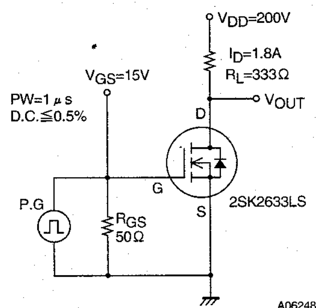
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta＝25°C

				unit
ドレイン・ソース電圧	V_{DSS}		800	V
ゲート・ソース電圧	V_{GSS}		±30	V
ドレイン電流(DC)	I_D		3	A
ドレイン電流(パルス)	I_{DP}		9	A
許容損失	P_D	Tc＝25°C	30	W
チャネル温度	Tch		150	°C
保存周囲温度	Tstg		−55〜＋150	°C

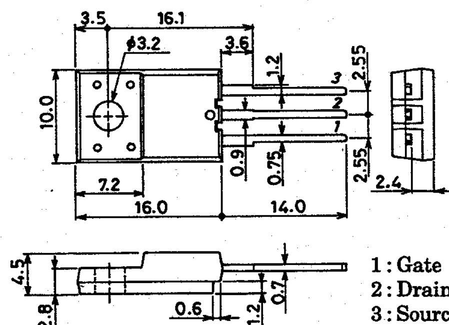
電気的特性 Electrical Characteristics / Ta＝25°C

			min	typ	max	unit
ゲート・ソース降伏電圧	$V_{(BR)DSS}$	I_D＝1mA, V_{GS}＝0	800			V
ドレイン・ソースしゃ断電流	I_{DSS}	V_{DS}＝800V, V_{GS}＝0			1.0	mA
ゲート・ソースもれ電流	I_{GSS}	V_{GS}＝±30V, V_{DS}＝0			±100	nA
カットオフ電圧	$V_{GS(off)}$	V_{DS}＝10V, I_D＝1mA	3.5		5.5	V
順伝達アドミタンス	$\|y_{fs}\|$	V_{DS}＝10V, I_D＝1.8A	0.9	1.8		S
飽和抵抗	$R_{DS(on)}$	I_D＝1.8A, V_{GS}＝15V		2.8	3.6	Ω
入力容量	Ciss	V_{DS}＝20V, f＝1MHz		700		pF
出力容量	Coss	V_{DS}＝20V, f＝1MHz		180		pF
帰還容量	Crss	V_{DS}＝20V, f＝1MHz		100		pF
ゲート入力電荷量	Qg	V_{DS}＝200V, I_D＝3A, V_{GS}＝10V		20		nC
ターンオン遅延時間	$t_{d(on)}$	下図指定回路において		20		ns
立上り時間	t_r	〃		20		ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(off)}$	〃		50		ns
下降時間	t_f	〃		25		ns
ダイオード順電圧	V_{SD}	I_S＝3A, V_{GS}＝0			1.2	V

スイッチングタイム測定回路図



外形図 2078B
(unit : mm)



1 : Gate
2 : Drain
3 : Source

SANYO : TO-220FI(LS)

本製品は開発中です。
詳細については営業担当者にご連絡ください。

〒370-05 群馬県大泉町坂田一丁目1番1号　三洋電機株式会社 半導体事業本部